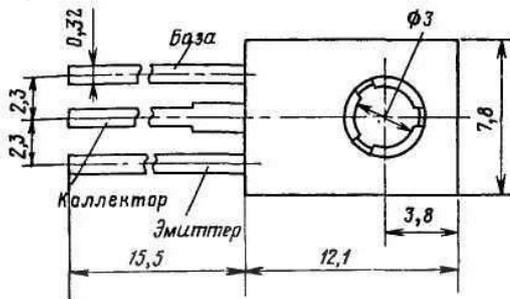


# КТ626А, КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* высокочастотные универсальные. Предназначены для работы в усилителях коротковолнового диапазона и переключающих схемах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 1,0 г.



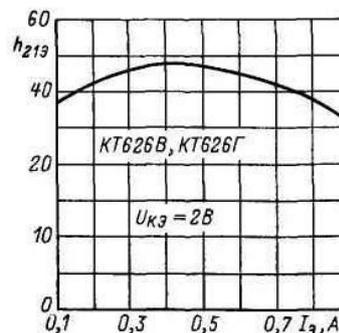
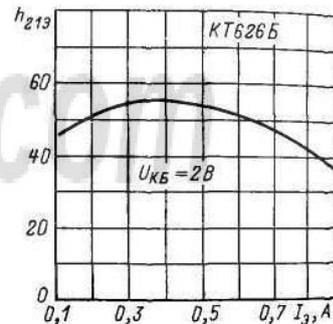
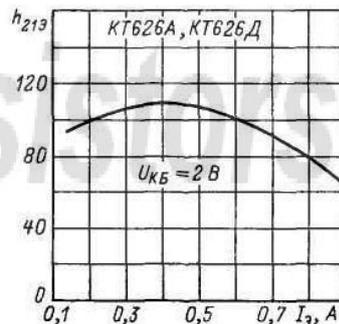
## Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА не менее.	
КТ626Б . . . . .	75 МГц
КТ626А, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д . . . . .	45 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 2$ В, $I_К = 0,15$ А:	
КТ626А . . . . .	40–250
КТ626Б . . . . .	30–100
КТ626В . . . . .	15–45
КТ626Г . . . . .	15–60
КТ626Д . . . . .	40–250
Обратный ток коллектора не более:	
КТ626А при $U_{КБ} = 30$ В . . . . .	10 мкА
КТ626Б, КТ626В при $U_{КБ} = 30$ В, КТ626Г, КТ626Д при $U_{КБ} = 20$ В . . . . .	150 мкА
Обратный ток эмиттера* при $U_{ЭБ} = 4$ В не более:	
КТ626А . . . . .	10 мкА
КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д . . . . .	300 мкА
Постоянная времени цепи обратной связи* на $f = 5$ МГц, при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА не более . . . . .	500 пс
Емкость коллекторного перехода* при $U_{КБ} = 10$ В не более . . . . .	150 пФ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ626А, КТ626Б при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ и КТ626В, КТ626Г, КТ626Д при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,1$ А не более . . . . .	1,0 В

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.	
КТ626А . . . . .	45 В
КТ626Б . . . . .	60 В
КТ626В . . . . .	80 В
КТ626Г, КТ626Д . . . . .	20 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	0,5 А
Импульсный ток коллектора . . . . .	1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T_к \leq 333$ К . . . . .	6,5 Вт
при $T_к = 358$ К . . . . .	4 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус . . . . .	10 К/Вт
Температура перехода . . . . .	398 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до $T_к = 333$ К

Примечание. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.